

日程表 (会場別 I)

会場名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
A21 (メインホールA)	09:00-11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15-18:00 15.4 III-V族窒化物結晶	08:45-12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:00-19:00 S.20 窒化物半導体の最新 線 - 欠陥のない結晶・デバイス を目標して -	09:00-12:00 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15-18:15 S.21 窒化物半導体特異構 造の科学 ~ 新機能の発現と 理解 ~	09:00-12:15 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15-15:30 15.4 III-V族窒化物結晶
A22 (メインホールB)	09:00-12:00 10.1 新物質創成 (酸化物・ ホイスラー、金属磁性体等)	13:15-18:15 S.9 酸化物エレクトロニクス の未来展望を描く	09:45-10:45 8.10 プラスエレクトロニクス 受賞記念講演	13:30-17:45 S.11 フォトシミュレーション の最新動向 ~ 大気圧、気流混合 プロセスの理解と制御にもつて ~	09:00-12:00 21.1 合同セッションK「ワイド ギャップ酸化物半導体材料・デ バイス」	13:30-18:00 21.1 合同セッションK「ワイド ギャップ酸化物半導体材料・デ バイス」	09:00-11:45 21.1 合同セッションK「ワイド ギャップ酸化物半導体材料・デ バイス」	12:45-14:15 21.1 合同セッションK「ワイド ギャップ酸化物半導体材料・デ バイス」
A23 (201B)	10:00-11:45 6.1 強誘電体薄膜	13:30-16:45 6.1 強誘電体薄膜	09:00-11:45 6.1 強誘電体薄膜	13:30-17:30 S.10 DLC膜の国際標準化 - 標準化を支える先端評価技 術と世界展開を覗いた産業界 用 -	09:00-11:45 15.8 結晶評価, 不純物・結 晶欠陥	13:15-18:45 15.8 結晶評価, 不純物・結 晶欠陥		
A24 (201A)	09:00-12:10 フェーズトリアル: 水窪憲和	13:00-15:10 フェーズトリアル: 大嶋重利	09:00-11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:00-18:00 S.22 太陽電池モジュール層 順性の現状と今後の展開	09:00-11:45 16.3 シリコン系太陽電池	13:00-17:30 16.3 シリコン系太陽電池	09:00-12:15 16.3 シリコン系太陽電池	13:15-16:15 16.3 シリコン系太陽電池
A25 (202)	09:00-12:30 7.4 量子ビーム界面構造計測	13:45-17:00 9.5 新機能材料・新物性	09:30-11:30 CS9.4&16.2 9.4&16.2 のコードシミュレーション	13:15-19:00 15.1バルク結晶成長	09:30-11:45 17.1 カーボンナノチューブ, 他 のナノカーボン材料	13:15-17:45 17.1 カーボンナノチューブ, 他 のナノカーボン材料	09:00-13:15 16.1 基礎物性・評価・プロセ ス・デバイス	
A26 (203-204)	10:00-12:00 インダストリアルチャプター拡張コ ア会議	13:15-18:00 6.2 カーボン系薄膜	09:00-11:45 6.2 カーボン系薄膜	13:15-17:45 6.2 カーボン系薄膜	09:00-12:00 6.2 カーボン系薄膜	15:45-17:45 13.7 ナノ構造・量子現象	10:00-11:45 13.7 ナノ構造・量子現象	
A31 (302A)	09:00-11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15-17:00 S.7 STMノベル賞&AFM発 明30周年記念シンポジウム ~ プロ・顕微鏡のこれまでと これから ~	09:30-12:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:30-17:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00-12:15 6.3 酸化物エレクトロニクス		09:30-11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	
A32 (302B)	09:30-11:45 17.2 グラフェン	13:15-18:00 S.8 薄膜・表面分野で活躍す る女性研究者	09:30-11:15 6.6 プロ・顕微鏡	13:15-17:30 6.6 プロ・顕微鏡	09:30-11:15 6.6 プロ・顕微鏡	13:15-17:00 S.6 フォトニックインテリジェ ンスの横断	09:00-11:45 17.3 層状物質	
A33 (301A)	09:00-12:10 フェーズトリアル: 早瀬修二	13:00-15:10 フェーズトリアル: 川田正	09:00-12:10 フェーズトリアル: 末和知	13:15-18:15 S.23 機能性原子薄膜材料 の新展開 - 成膜技術 -	09:00-11:45 17.2 グラフェン	13:15-18:15 17.2 グラフェン	09:00-11:15 17.2 グラフェン	
A34 (301B)	10:45-12:15 10.5 磁場応用	13:15-16:30 S.13 弱磁性物質への磁場効 果を利用した材料プロセス	09:45-11:30 13.10 化合物太陽電池	13:00-15:30 13.10 化合物太陽電池	09:30-11:30 13.10 化合物太陽電池	13:00-18:00 13.10 化合物太陽電池	08:45-12:15 S.12 熱電変換の現在と未 来: ZTはどこまで上がるのか?	
A35 (303-304)	09:00-11:45 13.9 光物性・発光デバイス	13:15-17:15 13.9 光物性・発光デバイス	09:00-11:45 13.9 光物性・発光デバイス	13:15-16:30 13.9 光物性・発光デバイス	09:00-12:00 9.4 熱電変換	13:30-18:00 9.4 熱電変換	09:00-11:45 3.13 半導体光子デバイス	13:15-15:30 3.13 半導体光子デバイス
A36 (305)			09:00-12:45 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資 源・環境	17:30-19:30 JSAP International Members Chapter (JIMeC) Networking Forum				
A37 (306-307)		13:15-17:45 4.6 Nanocarbon and 2D Materials	09:00-11:45 6.4 薄膜新材料	13:15-17:45 6.4 薄膜新材料	09:00-11:45 2.1 放射線物理一般・検出 器基礎	13:15-15:15 2.1 放射線物理一般・検出 器基礎	09:00-12:15 2.3 放射線応用・発生装置・ 新技術	
A41 (国際会議室)	10:15-10:45 講演奨励賞贈呈式	13:00-14:30 8.9 プラスエレクトロニクス分 科内招待講演	09:00-12:00 12.5 有機太陽電池	13:15-18:00 S.4 フォトニックデバイスシ ンポジウム「フォトニクスの未来を担う 研究者」	09:00-12:15 12.5 有機太陽電池	13:15-18:00 12.5 有機太陽電池	09:00-12:00 12.5 有機太陽電池	13:15-15:30 12.5 有機太陽電池

日程表 (会場別Ⅱ)

会場名	収容人数	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
B1 (展示ホール内)	208		13:15-18:00 S.15 ナノバイオテクノロジーバイオセンシングに関するポイントシンポジウム	11:45-12:15 13.8 化合物及びバワー電子デバイス・プロセス技術	13:45-16:15 S.18 AIおよびデータサイエンス時代の向けたIoT/10G5Gバイオ技術	09:00-12:30 13.8 化合物及びバワー電子デバイス・プロセス技術		09:00-12:30 13.8 化合物及びバワー電子デバイス・プロセス技術	13:30-17:00 13.8 化合物及びバワー電子デバイス・プロセス技術
B2 (展示ホール内)	112		13:45-17:00 3.10 光子物理・技術	09:00-12:00 3.9 テラヘルツ全般	13:15-18:15 3.9 テラヘルツ全般	10:00-12:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:45-17:30 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	09:00-12:30 3.9 テラヘルツ全般	
B3 (展示控室3)	64	09:00-12:15 3.5 レーザ・装置・材料	13:45-16:15 3.5 レーザ・装置・材料	09:30-12:15 CS3.5&3.14	13:45-16:30 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	09:00-11:15 13.2 探索的材料物性・基礎物性	13:45-16:45 13.2 探索的材料物性・基礎物性	09:00-10:30 6.5 表面物理・真空	13:45-16:15 6.5 表面物理・真空
B4 (展示ホール内)	112		13:15-15:30 12.5 有機太陽電池	10:30-11:45 3.15 シリコンフォトニクス	13:45-18:00 3.15 シリコンフォトニクス	09:00-12:15 CS3.11&13.7	13:45-15:45 CS3.11&13.7 3.11と13.7のコードシミュレーション	09:00-12:45 3.11 フォトニック構造・現象	
B5 (展示ホール内)	112	13:45-17:45 12.2 評価・基礎物性	13:45-17:45 12.2 評価・基礎物性	09:00-12:15 12.2 評価・基礎物性	13:45-17:00 12.2 評価・基礎物性	09:00-12:15 12.1 作製・構造制御	13:15-18:45 7.2 電子ビーム応用	09:00-12:30 12.1 作製・構造制御	
B6 (展示控室2)	46				13:45-17:15 7.5 イオンビーム一般				
B7 (展示ホール内)	112	09:00-11:45 8.2 プラズマ診断・計測	13:15-18:15 S.25 ナノ界面現象と評価技術の現状と課題	10:30-11:30 13.6 Semiconductor English Session	12:30-19:15 S.17 IV族半導体薄膜の結晶化と欠陥制御	09:00-12:30 8.1 プラズマ生成・制御	13:45-18:30 8.6 プラズママイクロサイエンス	09:00-11:30 8.5 プラズママイクロロジー	13:15-16:45 8.3 プラズマ成膜・表面処理
B8 (展示ホール内)	112	09:00-12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	13:45-18:00 S.19 古く新しい点欠陥～材料を越えた視点から見えてくるもの～	09:00-12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	13:45-18:00 S.5 量子技術へ向けたハイブリッドアプローチ	09:00-12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	13:30-17:30 CS3.14&3.15 3.14と3.15のコードシミュレーション	09:00-12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	
B9 (展示ホール内)	112	09:00-11:45 8.4 プラズマエッチング	13:30-18:00 S.26 多元系化合物の機能性評価技術の新展開～多元系デバイス開発への知見提供～	09:00-12:30 3.1 光学基礎・光学新領域	13:45-17:30 S.3 放射線医療現場における受動型検出器による計測手法の最近の進展	10:15-11:45 13.3 絶縁膜技術	13:15-17:45 13.3 絶縁膜技術	09:00-13:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	
B10 (展示控室1)	70	09:00-12:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:45-16:45 S.1 学習意欲向上のための授業改善～能動的学習に向けた実践事例について～	09:00-12:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:45-15:45 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00-12:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:45-18:30 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	09:00-12:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	13:45-17:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術
B11 (展示ホール内)	208	09:00-11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15-17:30 12.4 有機EL・トランジスタ	09:30-11:30 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15-17:00 12.4 有機EL・トランジスタ	09:30-12:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:45-19:00 S.16 バイオと共生する電子デバイスを目指して		
B12 (展示控室4A-4B)	104		13:00-18:00 2.2 検出器開発	09:00-12:00 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	13:30-18:15 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	09:30-12:15 22.1 合同セッションM「フロンティアエンジニアリング」	13:45-19:00 3.12 ナノ領域科学・近接場光学	09:00-12:15 3.12 ナノ領域科学・近接場光学	13:45-16:30 3.12 ナノ領域科学・近接場光学
B13 (展示控室5A-5B)	104	13:45-17:00 13.5 デバイス/集積化技術	13:45-17:00 13.5 デバイス/集積化技術	09:00-12:15 13.5 デバイス/集積化技術	13:45-18:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00-12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:45-15:30 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00-11:45 8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野	

B (朱鷺メッセ展示ホール内)

日程表 (会場別Ⅲ)

会場名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)		
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
C (ホテル日航新潟)	C31 (日航3階孔雀AB)	09:30-12:00 3.7 レーザープロセッシング	13:45-17:00 7.1 X線技術	09:30-12:15 3.7 レーザープロセッシング	13:45-17:30 3.7 レーザープロセッシング	09:15-12:15 4.2 Bio-and Medical Photonics	13:45-16:45 4.2 Bio-and Medical Photonics		
	C32 (日航3階孔雀CD)			09:15-12:15 3.6 超高速・高強度レーザー	13:45-17:30 3.6 超高速・高強度レーザー	09:00-12:15 3.8 光計測技術・機器	13:45-18:00 CS3.6&3.8	09:00-12:15 3.8 光計測技術・機器	
	C41 (日航4階朱雀A)		13:00-17:45 特別シンポジウム「超入門〜 社会へ向けた応用物理」〜第 5期科学技術基本計画への 期待と課題〜	09:00-10:30 10.2 スピントロクス・スピ ン流・測定技術	13:15-19:00 10.4 半導体・有機・光・量子 スピントロクス	09:00-10:30 10.3 GMR・TMR・磁気記録 技術	13:15-17:00 S.14 応用に向けた新規スピ ントロクス現象の物理	09:30-12:00 CS10.10.1, 10.2, 10.3, 10.4 コードシミュレーション 「新規スピントロクス操作 方法および関連現象」	
	C42 (日航4階白鷺)	09:45-12:00 9.3 ナノエレクトロニクス	13:30-16:00 9.3 ナノエレクトロニクス	13:45-18:00 4.8 Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering	15:15-19:00 4.3 Optical Micro- sensing, Manipulation, and Fabrications	09:00-12:15 3.3 情報フォトニクス・画像工 学	13:45-16:45 3.2 材料・機器光学	09:00-12:15 1.5 計測技術・計測標準 学	
C301 (日航30階鶴)	09:00-12:15 4.5 Information Photonics		13:45-18:00 4.8 Strong Light Excitation Phenomena Applied to Materials and Bio Engineering	15:15-19:00 4.3 Optical Micro- sensing, Manipulation, and Fabrications	10:30-12:15 CS3.6&3.8 3.6&3.8の コードシミュレーション	13:15-17:30 4.7 Terahertz Photonics	09:00-12:00 4.4 Opto-electronics		
C302 (日航30階鳳凰)	09:00-12:00 4.1 Plasmonics	13:45-18:00 S.24 ナノフォトニクスと熱の融 合	13:45-18:00 S.24 ナノフォトニクスと熱の融 合	13:45-14:45 OSA Vice President Special Lecture	09:00-12:15 4.1 Plasmonics	13:45-19:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	09:00-12:15 15.6 IV族系化合物 (SiC)		
D61 (万代島ビル6階 D1)	09:00-12:15 7.3 微細パターン・微細構造 形成技術	13:15-15:30 15.2 II-VI族結晶および多元 系結晶	13:15-15:30 15.2 II-VI族結晶および多元 系結晶	13:15-19:00 11.4 アナログ応用および関連 技術	09:00-11:45 11.4 アナログ応用および関連 技術	13:15-17:00 11.5 接合, 回路作製ロボ スおよびデバイス応用	09:00-11:45 15.5 IV族結晶, IV-IV族混 晶		
D62 (万代島ビル6階 D2)	09:00-12:15 6.4 薄膜新材料	13:45-17:30 6.4 薄膜新材料	13:45-17:30 6.4 薄膜新材料	13:30-19:00 9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子	09:30-11:45 9.1 誘電材料・誘電体				
D63 (万代島ビル6階 D3)	10:00-12:00 1.6 超音波	16:00-18:00 1.6 超音波	16:00-18:00 1.6 超音波	13:15-16:00 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作 業プロセスおよび結晶成長	09:15-11:15 11.1 基礎物性	12:45-17:45 11.1 基礎物性			
		D (万代島ビル6F)							

日程表 (会場別Ⅳ)

会場名	2016年9月13日(火)		2016年9月14日(水)		2016年9月15日(木)		2016年9月16日(金)			
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後		
P1 ～ P25		<p>[13:30-15:30]</p> <p>7.4 量子ビーム界面構造計測</p> <p>7.1 X線技術</p> <p>17 ナノカーボン</p> <p>1.6 超音波</p> <p>7.5 イオンビーム一般</p>	<p>[09:30-11:30]</p> <p>9.5 新機能材料・新物性</p> <p>11 超伝導</p> <p>3.8 光計測技術・機器</p> <p>13.8 化合物及びハイパー電子デバイス・プロセス技術</p> <p>1.2 教育</p> <p>12.3 機能材料・萌芽的デバイス</p>	<p>[13:30-15:30]</p> <p>6.1 強誘電体薄膜</p> <p>13.6 Semiconductor English Session</p> <p>21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」</p> <p>15.6 IV族系化合物 (SiC)</p> <p>13.5 デバイス/集積化技術</p> <p>13.4 Si系デバイス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術</p> <p>15.2 II-V族結晶および多元系結晶</p> <p>3.5 レーザー装置・材料</p> <p>13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション</p> <p>3.1 光学基礎・光学新領域</p>	<p>[16:00-18:00]</p> <p>12.6 ナノバイオテクノロジー</p> <p>1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境</p> <p>7.2 電子ビーム応用</p> <p>CS9.4&16.2</p> <p>13.10 化合物太陽電池</p> <p>1.3 新技術・複合新領域</p> <p>1.1 応用物理一般・学際領域</p> <p>S.15 ナノバイオテクノロジーバイオセンシングに関するジョイントシンポジウム</p> <p>7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術</p> <p>7.3 微細パターン・微細構造形成技術</p> <p>12.7 医用工学・バイオチップ</p> <p>3.11 フォトリソグラフィ構造・現象</p> <p>13.7 ナノ構造・量子現象</p>	<p>[13:30-15:30]</p> <p>16.3 シリコン系太陽電池</p> <p>8.2 プラズマ診断・計測</p> <p>6.3 酸化物エレクトロニクス</p> <p>15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶</p> <p>16.1 基礎物性・評価・プロセスデバイス</p> <p>6.2 カーボン系薄膜</p> <p>8.4 プラズマエッチング</p> <p>12.2 評価・基礎物性</p> <p>1.5 計測技術・計測標準</p> <p>8.3 プラズマ成膜・表面処理</p> <p>6.6 フローブ顕微鏡</p> <p>8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野</p> <p>13.9 光物性・発光デバイス</p>	<p>[09:30-11:30]</p> <p>3.15 シリコンフォトニクス</p> <p>9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子</p> <p>15.1 ハルワ結晶成長</p> <p>3.10 量子物理・技術</p> <p>3.13 半導体デバイス</p> <p>15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎</p> <p>3.7 レーザープロセスング</p> <p>3.4 生体・医用光学</p> <p>3.12 ナノ領域光学・近接場光学</p> <p>3.14 光制御デバイス・光ファイバー</p> <p>3.6 超高速・高強度レーザー</p>	<p>[16:00-18:00]</p> <p>6.5 表面物理・真空</p> <p>22 合同セッションM「フロンティア」</p> <p>9.1 誘電材料・誘電体</p> <p>2 放射線</p> <p>9.3 ナノエレクトロニクス</p>	<p>[13:30-15:30]</p> <p>8.5 プラズマナノテクノロジー</p> <p>12.1 作製・構造制御</p> <p>8.6 プラズマプラズマエッチング</p> <p>8.8 Plasma Electronics English Session</p> <p>12.4 有機EL・トランジスタ</p> <p>3.9 テラヘルツ全般</p> <p>8.1 プラズマ生成・制御</p>	
	P (朱鷺メッセ展示ホール)		<p>[16:00-18:00]</p> <p>10 スピントロニクス・マグネティック</p> <p>6.4 薄膜新材料</p> <p>4 JSAP-OSA Joint Symposia 2016</p> <p>12.5 有機太陽電池</p>							